行政院原子能委員會

委託研究計畫研究報告

電漿浸沒離子注入技術應用於人工植牙之性能提昇研究 Improving the property of dental implant using plasma immersion ion implantation technique

- 計畫編號:992001INER029
- 受委託機關(構):國立陽明大學
- 計畫主持人: 黃何雄 教授
- 核研所聯絡人員:蔡文發
- 聯絡電話:02-28267068
- E-mail address : hhhuang@ym.edu.tw
- 報告日期: 2010/12/15

目錄

目錄	Ι
中文摘要	1
英文摘要	2
壹、計劃源起與目的	3
貳、研究方法與過程	6
一、材料製備	6
二、表面形貌分析	6
三、表面化學成分分析	6
四、表面機械性質分析	7
五、表面親疏水性分析	7
六、耐蝕性質分析	8
七、凝血性質分析	9
(一) 全血凝固分析	9
(二) 血小板貼附分析	9
八、細胞相容性質分析	10
(一) 細胞培養	10
(二) 細胞貼附分析	10
(三) 細胞增生分析	11
(四) 初期細胞分化分析	12

参、主要發現與結論	13
一、表面形貌分析	13
二、表面化學成分分析	13
三、表面機械性質分析	15
四、表面親疏水性分析	16
五、耐蝕性質分析	16
六、凝血性質分析	17
七、細胞相容性質分析	18
八、結論	19
肆、參考文獻	21
伍、表及圖	25

中文摘要

本研究是使用氧離子電漿浸沒離子注入處理技術,藉由不同 的氧離子劑量(1×10¹⁶、4×10¹⁶及1×10¹⁷ ions/cm²)來提升純鈦金屬 表面耐蝕性質、凝血性質及細胞相容性質。分別使用原子力顯微 鏡、X 光光電子能譜儀、奈米壓痕試驗機及接觸角量測儀,來分 析純鈦金屬表面形貌、化學成分、機械性質及親水性質。耐蝕性 質分析是於模擬血漿環境下進行動電位極化曲線量測。凝血性質 分析包括全血凝固速率及血小板貼附能力。細胞相容性質分析是 使用人類骨髓間葉幹細胞來評估細胞貼附、增生及初期分化之能 力。研究結果顯示,氧離子電漿浸沒離子注入技術並不會對純鈦 金屬表面形貌造成明顯的改變,但能夠增加純鈦金屬表面氧化層 厚度、提高表面硬度、楊氏係數及親水性質。耐蝕性質分析結果 顯示,氧離子電漿浸沒離子注入處理能夠降低腐蝕速率及鈍化電 流。凝血性質分析結果顯示,氧離子電漿浸沒離子注入處理能夠 促進血小板的接觸活化。細胞相容性質分析結果顯示,氧離子電 浆浸沒離子注入處理能夠促進人類骨髓間葉幹細胞的貼附、增生 及初期分化能力。本研究結果證實,氧離子電漿浸沒離子注入處 理技術可增加純鈦金屬表面氧化層的厚度(主要是二氧化鈦),進 而提高純鈦金屬表面耐蝕性質、凝血性質及細胞相容性質。

Abstract

In this study, oxygen plasma immersion ion implantation (O-PIII) treatment, with different oxygen doses $(1 \times 10^{16}, 4 \times 10^{16})$ and 1×10^{17} ions/cm²), was utilized to improve the corrosion resistance, blood coagulation and cytocompatibility of Ti surface. Atomic force microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, nanoindenter and contact angle goniometer were used to analyze surface topography, chemical compositions, mechanical property and hydrophilic property of Ti specimens, respectively. Corrosion resistance of Ti specimens was evaluated by potentiodynamic polarization curve measurement in simulated blood plasma solution. Blood coagulation property of Ti surfaces was evaluated using whole blood clotting time and platelet adhesion observation. Adhesion, proliferation and initial differentiation of human mesenchymal stem cells (hMSCs) on Ti surfaces were studied. The results showed that the O-PIII treatment had no significant influence on the surface topography of Ti specimens. The thickness of oxide layer on the O-PIII treated Ti specimens increased with an increase in oxygen dose implanted. The O-PIII treated Ti specimens possessed higher surface hardness, Young's modulus and hydrophilic property than the untreated Ti specimen. Potentiodynamic polarization tests revealed that the O-PIII treated Ti surfaces had lower corrosion rate and passive current than the untreated Ti surface. The O-PIII treated Ti surfaces showed a better platelet activation than the untreated Ti surface. The adhesion, proliferation and initial differentiation of hMSCs on Ti surfaces were improved by O-PIII treatment. O-PIII treatment could enhance the corrosion resistance, blood coagulation and cytocompatibility of Ti surface due to the increase in surface thickness of Ti-oxides (mainly as TiO₂) on Ti.

壹、計畫緣起與目的

純鈦(titanium,Ti)金屬因為具有良好的機械性質及生物相容性質,所以是現今生醫材料最廣泛應用的金屬材料之一。由於 純鈦金屬會在表面自然形成一層薄薄的二氧化鈦(titanium dioxide,TiO₂),所以具有極佳的生物相容性質[1-5]。二氧化鈦 本身與生物組織的相容性極佳,且不易與周圍的生理環境起反應 [6,7]。然而,當純鈦金屬置於體內且具有荷重的情況下,此二氧 化鈦層可能會因為純鈦金屬與骨組織產生細微的移動而產生崩解 的情況,此現象會導致金屬顆粒或離子的釋出並進入生物組織內 [8,9]。此外,由於人體的血漿中含有鹽類或離子的存在,所以亦 可能會導致二氧化鈦層的崩解[10]。因此,必須改善純鈦金屬的 表面特性,以延長純鈦金屬在臨床上應用的壽命。

電浆浸沒離子注入 (plasma immersion ion implantation, PIII) 是一種新穎的表面改質技術,其可以改善材料的表面特性且不會 對材料的原始形貌造成破壞 [11]。PIII 的植入層即使是在不規則 的材料表面亦具有極佳的附著力 [12, 13]。金屬材料的耐蝕性質 是決定其壽命長短的重要因素,因為腐蝕會導致金屬材料表面的 崩解,並導致金屬材料內部元素的釋出 [14]。

在過去,已有研究學者將純鈦金屬經過氧離子電漿浸沒離子 注入(oxygen plasma immersion ion implantation, O-PIII)處理後,

在不同的環境下例如 Hank's 溶液、Ringer's 溶液及模擬體液 (simulated body fluid, SBF) 等去進行耐蝕性質評估 [10, 15-17]。儘管如此,當金屬材料植入人體內部後,第一個接觸到 的其實是血漿,因為血漿會立刻填滿材料與骨組織之間的空隙 [18]。而且血漿會與金屬材料產生較劇烈的反應,因為血漿中含 有大量的氯離子 (chloride ion, Cl^-), 氯離子的存在會促進腐蝕 反應的進行 [19]。再者,比較傳統模擬體液與人體血漿之離子濃 度差異,結果發現傳統模擬體液含有較高的氯離子及較低的碳酸 氫離子 (bicarbonate ion, HCO3⁻), 而模擬血漿 (simulated blood plasma, SBP)則具有與人體血漿相同的離子濃度 [20]。然而, 有關純鈦金屬經過O-PIII處理後,在血漿的環境中分析探討其腐 蝕行為之文獻至今亦是相當缺乏。更進一步,有學者藉由動物實 驗研究證實 O-PIII 處理能夠改善純鈦金屬的骨整合性 (osseointegration) [8,9,21]。儘管如此,有關純鈦金屬經過O-PIII 處理後,影響細胞反應機制之文獻至今亦是相當缺乏。

因此,本研究將使用 O-PIII 處理並配合不同的離子劑量來改 善純鈦金屬表面的耐蝕性質、凝血性質及生物相容性質。耐蝕性 質 分 析 是 於 模 擬 血 漿 環 境 下 進 行 動 電 位 極 化 曲 線 (potentiodynamic polarization curve)量測。凝血性質分析包括全 血凝固速率及血小板貼附能力。細胞相容性質分析是使用人類骨 髓間葉幹細胞(human mesenchymal stem cells, hMSCs)來評估 細胞貼附、增生及初期分化之能力。

貳、研究方法與過程

一、材料製備

本研究選用商業用二級純鈦金屬試片(直徑 16 mm、厚度 1 mm)做為研究基材。純鈦金屬試片表面會先使用碳化矽(SiC) 砂紙研磨至#1200後,再分別使用去離子水及酒精清洗純鈦金屬 試片表面。O-PIII處理是在一個高真空度(8.5×10^{-6} torr)的腔體 內進行,並使用無線射頻(radio frequency)做為電漿源。本研究 選用 3 組不同的氧離子劑量(低劑量: 1×10^{16} ions/cm²;中劑量: 4×10^{16} ions/cm²;高劑量: 1×10^{17} ions/cm²)進行 O-PIII處理,分 別命名為 T_L、T_M及 T_H。未經過 O-PIII處理的純鈦金屬試片(對 照組:control group)則命名為 T_C。

二、表面形貌分析

使用原子力顯微鏡 (atomic force microscope, AFM) (Veeco Metrology Inc., Santa Barbara, CA, USA) 分析 O-PIII 處理前後純 鈦金屬試片表面三維形貌及粗糙度之變化。每個純鈦金屬試片表 面的掃描區域為 50 × 50 μm。

三、表面化學成分分析

使用 X 光光電子能譜儀(X-ray photoelectron spectrometer,

XPS)(Thermo VG Scientific Inc., East Grinstead, West Sussex, UK) 分析 O-PIII處理前後純鈦金屬試片表面化學成分之變化。以單色 的 Al Kα 做為 X 光光源,每個純鈦金屬試片表面的分析區域為直 徑 400 μm。純鈦金屬試片表面深度分析之估算是參照儀器的操作 手冊, 蝕刻時間 (sputtering time) 1 秒約減少氧化層厚度 1 Å。

四、表面機械性質分析

使用奈米壓痕試驗機 (nanoindenter) (MTS Nano Instruments Inc., Oak Ridge, TN, USA) 分析 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表 面硬度及楊氏係數(彈性模數)之變化。使用三角錐狀的 Berkovich 鑽石做為試驗機的壓痕尖端,並以連續剛性量測 (continuous stiffness measurement) 的技術進行分析,最大的分析深度為 100 nm。

五、表面親疏水性分析

使用接觸角量測儀 (contact angle goniometer) (Model 100SB, Sindatek, Taiwan) 分析 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片親 疏水性之變化。量測的過程是將試片置於平台上,並將水溶液滴 在試片表面,然後擷取水溶液與試片表面接觸瞬間之影像, 再藉 由分析軟體進一步取得水溶液與試片表面之接觸角, 接觸角的大

小可以用來評估純鈦金屬試片親疏水性之變化,接觸角越小代表材料表面的親水性越佳。

六、耐蝕性質分析

使用恆電位儀 (potentiostat) (Jiehan Technology Co., Beitun Taichung, Taiwan) 來進行動電位極化曲線 District. (potentiodynamic polarization curve)量測,以評估 O-PIII 處理前 後純鈦金屬試片表面耐蝕性質之變化。測試的過程中,是以模擬 血漿 (simulated blood plasma, SBP) 做為電解液,其成分包含 NaCl (5.403 g/L) $Na_2CO_3(2.046 \text{ g/L})$ $Na_2SO_4(0.072 \text{ g/L})$ $NaHCO_3$ (0.740 g/L) KCl (0.225 g/L) CaCl₂(0.293 g/L) MgCl₂·6H₂O (0.311g/L)、K₂HPO₄·3H₂O (0.230 g/L)及 C₈H₁₈N₂O₄S (11.928 g/L), 並藉 由 NaOH 調整 pH 值至 7.4。以純鈦金屬試片、白金片 (platinum sheet)及飽和甘汞電極(saturated calomel electrode)分別做為工 作電極(working electrode)、相對電極(counter electrode)及參 考電極 (reference electrode)。動電位極化曲線量測是從-0.8 V (SCE) 往陽極方向進行掃描,而掃描速率為1mV/s。當電流密 度超過1 mA/cm² 或電壓達到2 V 即停止量測。動電位極化曲線 量測前,電解液會先使用氮氣進行除氧1個小時。藉由動電位極 化曲線可得到各項腐蝕參數,包含腐蝕速率(corrosion rate, I_{corr}) 及鈍化電流 (passive current, *I*_{pass}),藉此可以用來評估純鈦金屬 試片表面耐蝕性質之變化。

七、凝血性質分析

(一) 全血凝固分析

將試片置於 12 孔細胞培養盤中,於試片表面加入 100 µl 血 液作用 3 及 6 分鐘。作用完後各加入 1 mL 的去離子水作用 10 分鐘後將試片取出,接著再由細胞培養盤中分別取出 0.5 mL 的溶 液,並加入 Drabkin's 溶劑作用 5 分鐘進行呈色,最後使用酵素免 疫分析儀(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA reader) (PowerWave X340, Bio-Tek, USA) 在 540 nm 的波長下測量其 吸光值 (optical density, OD),以測定溶液中血紅素之含量,吸 光值越高代表溶血量越多,而溶血量與凝血量成反比。

(二) 血小板貼附分析

抽取成人之全血於 3.2 %檸檬酸鈉 (sodium citrate, C₆H₅Na₃O₇)抗凝血劑中混合均匀,以1500 rpm 轉速離心5分鐘 取得上清液為富含血小板血浆(platelet rich plasma, PRP)。接著, 將富含血小板血浆置於試片表面,於5.0% CO₂、37℃環境下培 養5分鐘後,利用磷酸緩衝溶液(phosphate buffered saline, PBS) 清洗以移除試片表面未貼附的血小板。接著將試片表面的血小板 進行固定、脫水處理,最後使用場發射掃描式電子顯微鏡(field emission scanning electron microscope, FE-SEM)(JEOL Ltd., Musashino, Tokyo, Japan)觀察血小板於試片表面之貼附形態。

八、細胞相容性質分析

(一) 細胞培養

本研究選用人類骨髓間葉幹細胞(human bone marrow mesenchymal stem cells, hMSCs)來評估 O-PIII處理前後純鈦金 屬試片表面細胞貼附、增生及初期分化之能力。首先將細胞置於 培養液(Dulbecco's Modified Eagle's Medium, DMEM)中,並加 入 50 µg/mL 去活化胎牛血清(dialyzed fetal bovine serum, dFBS)、100 µg/mL 青黴素(penicillin)、100 µg/mL 鏈黴素 (streptomycin)及 370 µg/mL 碳酸氫鈉(sodium bicarbonate, NaHCO₃)。接著再將細胞培養於含有 5 % 二氧化碳(carbon dioxide, CO₂)且溫度控制於 37 ℃之培養箱中。

(二) 細胞貼附分析

純鈦金屬試片在與細胞共培養之前,會先使用紫外光 (ultraviolet,UV)滅菌 30 分鐘。接著,將 1×10⁴個細胞均勻種 上純鈦金屬試片表面,再放入培養箱分別培養24個小時。之後, 將已貼附細胞的純鈦金屬試片進行固定、脫水(dehydration)及 臨界點乾燥(critical point drying, CPD)。最後,使用場發射掃描 式電子顯微鏡觀察純鈦金屬試片表面細胞的貼附形態。

(三) 細胞增生分析

MTT(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide)為水溶性的黃色染劑,若與活細胞粒線體中的酵素交互 作用後,會轉變為深紫色且不溶於水的 MTT-formazan 結晶,而 此水溶液的反應速率會與細胞增生的數目成正比,藉此來進行細 胞初期增生能力之評估。

實驗過程先在純鈦金屬試片表面均勻種上 0.5×10⁴ 個細胞, 放入培養箱分別培養1及3天後,將種有細胞的純鈦金屬試片取 出,先加入 MTT 染劑進行反應,等待反應完畢再加入異丙醇 (isopropanol),以溶解 MTT 與細胞反應之結晶,最後使用酵素 免疫分析儀(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA reader) (PowerWave X340, Bio-Tek, USA) 在 570 nm 的波長下測量 其吸光值 (optical density, OD)。吸光值越高代表細胞增生的數 量越多。

(四) 初期細胞分化分析

茜素紅S(Alizarin red S, C₁₄H₇NaO₇S)為橘紅色的染劑, 細胞外基質於礦化初期會有鈣離子的沉積,而茜素紅S可與細胞 中的鈣離子反應呈色,而鈣離子的沉積會與細胞分化的數目成正 比,藉此來進行細胞初期分化能力之評估。

實驗過程先在純鈦金屬試片表面均勻種上 0.5×10⁴ 個細胞, 放入培養箱分別培養 7 及 14 天後,將種有細胞的純鈦金屬試片取 出,先加入酒精進行脫水,接著再加入茜素紅 S 染劑進行反應, 等待反應完畢後再加入氯化十六烷基吡啶 (hexadecylpyridinium chloride monohydrate),以溶解茜素紅 S 與細胞反應之呈色,最後 使用酵素免疫分析儀在 550 nm 的波長下測量其吸光值。吸光值 越高代表細胞分化的數量越多。

參、主要發現與結論

一、表面形貌分析

圖 1 為 AFM 分析 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面之三維 形貌(three-dimensional topography)。結果顯示,未經過 O-PIII 處理的 T_C 試片,其表面形貌主要是由平行的溝槽紋路所組成,此 表面形貌是純鈦金屬試片於材料製備的過程中,經由碳化矽砂紙 研磨所產生的紋路。經過 O-PIII 處理後,可在 T_L、T_M及 T_H試片 表面看到相似的表面形貌,且沒有任何明顯的缺陷產生。另外, 藉 由表 面 三 維 形 貌所 求 得 之 中 心 線 平 均 粗 糙 度 (average roughness, R_a),4 組不同試片其 R_a 值皆約為 0.18 μm。AFM 分析 結果證實,O-PIII 處理並不會改變純鈦金屬試片原始的表面形貌。

二、表面化學成分分析

圖 2 為 XPS 分析 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面化學成分 之縱深分佈(depth profiling)曲線圖。分析 Ti 及 O 元素原子百 分比與表層深度之變化,藉此來推算表面氧化層的厚度。結果顯 示, T_C 、 T_L 、 T_M 及 T_H 試片其表面氧化層的厚度依序約為 30 nm、 120 nm、170 nm 及 210 nm。圖 3 為 XPS 分析 O-PIII 處理前後純 鈦金屬試片表面之 Ti_{2p}曲線擬合(curve fitting)光譜圖。Ti_{2p}光譜 圖主要是由 4 個化學組態所組成,包含 Ti⁰(Ti)、Ti⁺²(TiO)、 Ti⁺³(Ti₂O₃)及Ti⁺⁴(TiO₂)。Ti、TiO、Ti₂O₃及TiO₂之束縛能(binding energy) 是參考相關的文獻得知 [22]。結果顯示,未經過O-PIII 處理的T_C 試片,其表面主要成分為Ti(純Ti),並含有少量的 TiO₂、Ti₂O₃及TiO。經過O-PIII處理的T_L、T_M及T_H試片,其表 面主要成分依次為TiO₂、Ti₂O₃及TiO。另外,藉由Ti₂p曲線擬合 光譜圖所求得各個氧化物之原子百分比,列於表 1。結果顯示, 未經過O-PIII處理的T_C試片,其表面TiO₂氧化物的含量約為33 %。經過O-PIII處理的T_L、T_M及T_H試片,其表面TiO₂氧化物的 含量依序約為40%、44%及49%。

XPS 縱深分佈曲線圖中,O 元素分佈的深度會隨著O 離子注 入劑量的提高而有明顯增加的趨勢,這是因為在 PIII 處理的過程 中會有溫度的產生,溫度上升會使 O 離子產生熱擴散 (thermal diffusion)的效應,而往材料的內層移動 [23,24]。而 O 離子注入 的劑量愈高所需 O-PIII 處理的時間也愈長,所以 O 離子擴散的時 間也愈久,深度也愈深。相對地,Ti 元素分佈的深度則會隨著 O 離子注入劑量的提高而有明顯減少的趨勢,這是因為 O 離子往材 料內層進行擴散後,會導致原本位在材料內層的 Ti 原子,往材料 更深層進行擴散 [25]。XPS 分析結果證實,純鈦金屬試片表面氧 化層的厚度會隨著 O 離子注入劑量的提高而有明顯增厚的趨勢, 此氧化層主要的成分為 TiO₂。

三、表面機械性質分析

圖4及圖5為奈米壓痕試驗機量測O-PIII處理前後純鈦金屬 試片表面硬度及楊氏係數之曲線圖。首先,比較3組不同試片表 面硬度之差異,結果顯示,未經過O-PIII處理的 T_C 試片,其表 面最大的硬度約為5GPa,深度約在10nm。經過O-PIII處理後, T_L 、 T_M 及 T_H 試片表面最大的硬度依序約為8GPa、12GPa及10 GPa,深度依序約在10nm、10nm及20nm。接著,比較3組不 同試片表面楊氏係數之差異,結果可看到與表面硬度相似的趨 勢。經過O-PIII處理後, T_L 、 T_M 及 T_H 試片表面最大的楊氏係數 依序約為189GPa、219GPa及207GPa,深度都約在10nm。未 經過O-PIII處理的 T_C 試片,其表面最大的楊氏係數約為184 GPa,深度約在10nm。

奈米壓痕試驗曲線圖中,硬度及楊氏係數會隨著O離子注入 劑量的提高而有明顯提升的趨勢,這是因為在 PIII 處理的過程 中,會導致材料表面的晶格變形(lattice deformation)及固溶硬 化(solution hardening) [23]。另外,在 PIII 處理的過程中,高 能量的離子撞擊到材料表面的原子,亦會使原子產生位移的現象 [26]。藉由上述這些理論可以說明為何 O-PIII 處理可提升純鈦金 屬試片表面的硬度及楊氏係數。

四、表面親疏水性分析

圖 6 為接觸角量測儀量測 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面 之水接觸角圖。結果顯示,經過 O-PIII 處理的 T_L、T_M及 T_H試片 與未經過 O-PIII 處理的 T_C 試片相比,其水滴附著情況較佳。另 外,藉由水滴附著形態所求得之接觸角,列於表 2。結果顯示, 未經過 O-PIII 處理的 T_C 試片,其表面水接觸角約為 40°。經過 O-PIII 處理的 T_L、T_M及 T_H試片,其表面水接觸角依序約為 33°、 33°及 13°。

五、耐蝕性質分析

圖7為恆電位儀量測 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片於模擬血 漿中之動電位極化曲線圖。藉由動電位極化曲線所求得之各項腐 蝕參數,包含腐蝕速率 (I_{corr})及鈍化電流 (I_{pass}),列於表3。首 先,比較4組不同試片腐蝕速率之差異,結果顯示, T_C 、 T_L 、 T_M 及 T_H 試片其腐蝕速率依序約為0.064 μ A/cm²、0.016 μ A/cm²、0.035 μ A/cm²及0.056 μ A/cm²。接著,比較4組不同試片鈍化電流之差 異,結果顯示, T_C 、 T_L 、 T_M 及 T_H 試片其鈍化電流依序約為4.696 μ A/cm²、0.083 μ A/cm²、0.080 μ A/cm²及0.087 μ A/cm²。

動電位極化曲線圖中,腐蝕速率及鈍化電流值愈低表示測試的材料具有較佳的耐蝕性質。統計分析結果顯示,O-PIII處理的

T_L、T_M及T_H試片與未經過O-PIII 處理的T_C試片相比,其具有較低的腐蝕速率及鈍化電流。耐蝕性質分析結果證實,O-PIII 處理 可提升純鈦金屬試片於模擬血漿中之耐蝕性質,這是因為純鈦金 屬試片經過O-PIII 處理後,會增加試片表面氧化層的厚度(如圖 2所示)。另外,Tan等人 [10] 指出在PIII 處理的過程中,氧化 物會擴散到鈦合金的表面,而產生很強的再鈍化能力 (repassivation ability)。另一方面,Poon等人 [15] 提出PIII 處 理可提升鈦合金的耐蝕性質,這是由於PIII 處理的過程中,O離 子會與材料表面的Ti 原子形成很強的鍵結。藉由上述這些理論可 以說明為何 O-PIII 處理可提升純鈦金屬試片表面的耐蝕性質。

六、凝血性質分析

圖 8 為利用 FE-SEM 觀察 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面 血小板之貼附形態。結果顯示,經過 O-PIII 處理後的試片表面其 血小板有較佳的貼附型態,血小板的偽足會順著試片表面的結構 伸展且血小板本身也會順著試片表面的結構攤平延展。

圖9為利用全血凝固分析評估 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片 表面對於初期血液凝固之影響。結果顯示,經過 O-PIII 處理的 T_M 試片,其表面血液有最多的溶血量,即凝血性最差;而經過 O-PIII 處理的 T_H試片,其表面血液的溶血量最低,即凝血性最好。

七、細胞相容性質分析

圖 10 為 FE-SEM 觀察 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面細 胞之貼附形態。經過 24 個小時的培養後,細胞皆已完全貼附於 3 組不同試片的表面。首先,觀察圖 10 (a)-(d),結果顯示,經過 O-PIII 處理的 T_L、T_M及 T_H試片,其表面的細胞密度高於未經過 O-PIII 處理的 T_C試片。接著,觀察圖 10 (e)-(h),結果顯示,經過 O-PIII 處理的 T_L、T_M及 T_H試片與未經過 O-PIII 處理的 T_C試片相 比,其表面的細胞具有較佳的貼附性及延展性。

圖 11 為 MTT 染劑分析 hMSCs 於 O-PIII 處理前後純鈦金屬 試片表面培養 1 及 3 天後之增生情形。首先,比較培養 1 天後之 增生情形,結果顯示,經過 O-PIII 處理的 T_L 、 T_M 及 T_H 試片,其 表面 hMSCs 的增生量多於未經過 O-PIII 處理的 T_C 試片。接著, 比較培養 3 天後之增生情形,結果顯示,經過 O-PIII 處理的 T_L 、 T_M 及 T_H 試片,其表面 hMSCs 的增生量亦多於未經過 O-PIII 處理 的 T_C 試片。

圖 12 為茜素紅 S 染劑分析 hMSCs 於 O-PIII 處理前後純鈦金 屬試片表面培養 7 及 14 天後之初期分化情形。首先,比較培養 7 天後之初期分化情形,結果顯示,經過 O-PIII 處理的 T_L 及 T_M 試 片,其表面 hMSCs 的分化量多於未經過 O-PIII 處理的 T_C 試片。 接著,比較培養 14 天後之初期分化情形,結果顯示,經過 O-PIII

處理的 T_L 及 T_M 試片,其表面 hMSCs 的分化量亦多於未經過 O-PIII 處理的 T_C 試片。

在過去,McCafferty 等人 [27] 提出當金屬表面氧化物的等 電點(isoelectric point)低於水溶液的 pH 值時,金屬氧化物會與 吸附在表面的水分子(H₂O)產生反應,並帶走一個氫離子(H), 此時吸附在金屬表面的離子大部份就僅剩下氫氧根(OH⁻),因此 會導致金屬表面的氧化物帶有負電(negative charge)。另外,Kurrat 等人 [28] 證實 TiO₂ 層的等電點約為 4.5,低於一般中性環境的 pH 值(約為 7.0),所以 TiO₂層會帶有負電。更進一步,Ohgaki 等人 [29] 證實帶有負電的表面能夠促進鈣離子(Ca²⁺)的吸附, 而鈣離子吸附之後,能夠吸引到細胞貼附蛋白例如整含蛋白 (integrin)、纖維蛋白(fibronectin)及玻連蛋白(vitronectin) 等,因此能夠促進細胞的附著及貼附。綜合上述這些理論,可以 說明為何 O-PIII 處理可促進純鈦金屬試片表面細胞的貼附性及延 展性。

八、結論

本研究使用 O-PIII 處理可在純鈦金屬表面形成混合的成分 (主要是 TiO₂)。與未經過 O-PIII 處理的純鈦金屬相比,O-PIII 處理的純鈦金屬具有較高的表面硬度及楊氏係數、較低的腐蝕速 率及鈍化電流、較佳的凝血性質、較佳的細胞貼附、增生及初期 分化。本研究結果證實,O-PIII處理可提升純鈦金屬表面耐蝕性 質、凝血性質及細胞相容性質。

肆、參考文獻

- Larsson C, Lardelli M, White I, Lendahl U. The human NOTCH1, 2, and 3 genes are located at chromosome positions 9q34, 1p13-p11, and 19p13.2-p13.1 in regions of neoplasia-associated translocation. Genomics 1994;24(2):253-258.
- Pan J, Liao H, Leygraf C, Thierry D, Li J. Variation of oxide films on titanium induced by osteoblast-like cell culture and the influence of an H₂O₂ pretreatment. Journal of Biomedical Materials Research 1998;40(2):244-256.
- Chiang C-Y, Chiou S-H, Yang W-E, Hsu M-L, Yung M-C, Tsai M-L, et al. Formation of TiO₂ nano-network on titanium surface increases the human cell growth. Dental Materials 2009;25(8):1022-1029.
- Yang W-E, Hsu M-L, Lin M-C, Chen Z-H, Chen L-K, Huang H-H. Nano/submicron-scale TiO₂ network on titanium surface for dental implant application. Journal of Alloys and Compounds 2009;479(1-2):642-647.
- Yang W-E, Huang H-H. Improving the biocompatibility of titanium surface through formation of a TiO₂ nano-mesh layer. Thin Solid Films 2010;518(24):7545-7550.
- Tan L, Crone WC. Surface characterization of NiTi modified by plasma source ion implantation. Acta Materialia 2002;50(18):4449-4460.
- Lackner JM, Waldhauser W, Ebner R, Major B, Schöberl T. Pulsed laser deposition of titanium oxide coatings at room temperature-structural, mechanical and tribological properties. Surface and Coatings Technology 2004;180-181:585-590.
- 8. Mändl S, Krause D, Thorwarth G, Sader R, Zeilhofer F, Horch

HH, et al. Plasma immersion ion implantation treatment of medical implants. Surface and Coatings Technology 2001;142-144:1046-1050.

- Mändl S, Sader R, Thorwarth G, Krause D, Zeilhofer HF, Horch HH, et al. Investigation on plasma immersion ion implantation treated medical implants. Biomolecular Engineering 2002;19(2-6):129-132.
- Tan L, Dodd RA, Crone WC. Corrosion and wear-corrosion behavior of NiTi modified by plasma source ion implantation. Biomaterials 2003;24(22):3931-3939.
- 11. Yeung KWK, Poon RWY, Liu XY, Ho JPY, Chung CY, Chu PK, et al. Corrosion resistance, surface mechanical properties, and cytocompatibility of plasma immersion ion implantation-treated nickel-titanium shape memory alloys. Journal of Biomedical Materials Research Part A 2005;75A(2):256-267.
- Mändl S, Rauschenbach B. Improving the biocompatibility of medical implants with plasma immersion ion implantation. Surface and Coatings Technology 2002;156(1-3):276-283.
- Tian XB, Chu PK, Fu R, Yang SQ. Hybrid processes based on plasma immersion ion implantation: a brief review. Surface and Coatings Technology 2004;186(1-2):190-195.
- 14. Chaturvedi T. An overview of the corrosion aspect of dental implants. Indian Journal of Dental Research 2009;20(1):91-98.
- 15. Poon RWY, Ho JPY, Liu X, Chung CY, Chu PK, Yeung KWK, et al. Improvements of anti-corrosion and mechanical properties of NiTi orthopedic materials by acetylene, nitrogen and oxygen plasma immersion ion implantation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 2005;237(1-2):411-416.
- 16. Yankov RA, Shevchenko N, Rogozin A, Maitz MF, Richter E,

Moller W, et al. Reactive plasma immersion ion implantation for surface passivation. Surface and Coatings Technology 2007;201(15):6752-6758.

- Muñoz-Castro AE, López-Callejas R, Granda-Gutiérrez EE, Valencia-Alvarado R, Barocio SR, Peña-Eguiluz R, et al. Ion implantation of oxygen and nitrogen in CpTi. Progress in Organic Coatings 2009;64(2-3):259-263.
- Yang Y, Oh N, Liu Y, Chen W, Oh S, Appleford M, et al. Enhancing osseointegration using surface-modified titanium implants. JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society 2006;58(7):71-76.
- Virtanen S, Milosev I, Gomez-Barrena E, Trebse R, Salo J, Konttinen YT. Special modes of corrosion under physiological and simulated physiological conditions. Acta Biomaterialia 2008;4(3):468-476.
- Oyane A, Kim HM, Furuya T, Kokubo T, Miyazaki T, Nakamura T. Preparation and assessment of revised simulated body fluids. Journal of Biomedical Materials Research Part A 2003;65A(2):188-195.
- 21. Mändl S, Sader R, Thorwarth G, Krause D, Zeilhofer HF, Horch HH, et al. Biocompatibility of titanium based implants treated with plasma immersion ion implantation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 2003;206:517-521.
- Moulder JF, Stickle WF, Sobol PE, Bomben KD. Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy. Eden Prairie, Minnesota: Physical Electronics, Inc., 1995.
- 23. Li J, Sun M, Ma X, Tang G. Structure and tribological performance of modified layer on Ti6Al4V alloy by plasma-based ion implantation with oxygen. Wear

2006;261(11-12):1247-1252.

- 24. Valencia-Alvarado R, de la Piedad-Beneitez A, López-Callejas R, Barocio SR, Mercado-Cabrera A, Peña-Eguiluz R, et al. Oxygen implantation and diffusion in pure titanium by an rf inductively coupled plasma. Vacuum 2009;83(Supplement 1):264-267.
- 25. Tan L, Shaw G, Sridharan K, Crone WC. Effects of oxygen ion implantation on wear behavior of NiTi shape memory alloy. Mechanics of Materials 2005;37(10):1059-1068.
- Shi W, Li XY, Dong H. Improved wear resistance of ultra-high molecular weight polyethylene by plasma immersion ion implantation. Wear 2001;250(1-12):544-552.
- McCafferty E, Wightman JP. Determination of the concentration of surface hydroxyl groups on metal oxide films by a quantitative XPS method. Surface and Interface Analysis 1998;26(8):549-564.
- Kurrat R, Wälivaara B, Marti A, Textor M, Tengvall P, Ramsden JJ, et al. Plasma protein adsorption on titanium: comparative in situ studies using optical waveguide lightmode spectroscopy and ellipsometry. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 1998;11(4):187-201.
- Ohgaki M, Kizuki T, Katsura M, Yamashita K. Manipulation of selective cell adhesion and growth by surface charges of electrically polarized hydroxyapatite. Journal of Biomedical Materials Research 2001;57(3):366-373.

伍、表及圖

表 1、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面各個氧化物之原子百分比。

Component	Ti ⁰		Ti ⁺²		Ti ⁺³		Ti ⁺⁴			rm2+41/rm2+2 + m2+3 + m2+41			
Group	Mean	Mediar	n SD	Mean	Median	SD	Mean	Mediat	n SD	Mean	Mediat	n SD	$[\Pi^{,i}]/[\Pi^{,2} + \Pi^{,0} + \Pi^{,i}]$
T _C	51.69	54.19	4.56	15.19	15.77	1.02	17.17	16.21	4.59	15.95	16.90	2.08	33
T_L	11.85	12.37	2.02	22.86	24.37	4.75	30.08	32.63	6.50	35.21	37.07	3.58	40
T_{M}	12.14	11.43	2.48	19.90	19.36	3.80	29.08	30.05	3.88	38.90	38.68	0.86	44
T _H	12.66	12.49	2.39	18.73	19.05	1.26	25.69	28.24	5.00	42.91	41.60	2.57	49

表 2、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面之水接觸角。

	Contact angle	ddH ₂ O (degree)				
Group		Mean	SD			
	T _C	40.36	1.45			
	T_L	33.28	1.45			
	T_{M}	33.64	1.06			
	T _H	13.34	1.39			

表 3、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片於模擬血漿中之各項腐蝕參

數。

Parameter	I _{corr} (μA/cm ²)	Ipass (µA/cm ²)			
Group	Mean SD	Mean SD			
T _C	0.064 0.012	4.696 0.063			
T_L	0.016 0.006	0.083 0.007			
$\mathbf{T}_{\mathbf{M}}$	0.035 0.005	0.080 0.004			
T _H	0.056 0.010	0.087 0.014			



圖 1、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片之原子力顯微鏡表面三維形 $\hat{n}:$ (a) untreated T_C ; (b) treated T_L ; (c) treated T_M ; (c) treated T_H 。



圖 2、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面化學成分之 X 光光電子 能譜儀縱深分佈曲線圖: (a) untreated T_C ; (b) treated T_L ; (c) treated T_M ; (c) treated T_H 。



圖 3、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面之 X 光光電子能譜儀 Ti_{2p} 曲線擬合光譜圖: (a) untreated T_C; (b) treated T_L; (c) treated T_M; (c) treated T_H。



圖 4、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面硬度之曲線圖: (a) untreated T_C ; (b) treated T_L ; (c) treated T_M ; (c) treated T_H 。



圖 5、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面楊氏係數之曲線圖: (a) untreated T_C ; (b) treated T_L ; (c) treated T_M ; (c) treated T_H 。



圖 6、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面之水接觸角圖: (a) untreated T_C ; (b) treated T_L ; (c) treated T_M ; (c) treated T_H 。



圖 7、O-PIII 處理前後純鈦金屬試片於模擬血漿中之動電位極化 曲線圖: (a) untreated T_C ; (b) treated T_L ; (c) treated T_M ; (c) treated T_H 。



圖 8、FE-SEM 觀察 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面血小板經 過五分鐘反應後之貼附形態: (a)、(b)、(c)及(d)分別為 T_C、T_L、 T_M及 T_H,放大倍率為 X2000; (e)、(f)、(g)及(h)分別為 T_C、T_L、 T_M及 T_H,放大倍率為 X5000。



圖 9、全血分別於各試片表面凝血三分鐘及六分鐘後加入一次水 觀察其溶血程度。



圖 10、FE-SEM 觀察 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表面細胞經過 24 個小時培養後之貼附形態: (a)、(b)、(c)及(d)分別為 T_C、T_L、 T_M及 T_H,放大倍率為 X100;(e)、(f)、(g)及(h)分別為 T_C、T_L、 T_M及 T_H,放大倍率為 X2000。



圖 11、MTT 染劑分析 hMSCs 於 O-PIII 處理前後純鈦金屬試片表 面培養 1 及 3 天後之增生情形: (a) untreated T_C ; (b) treated T_L ; (c) treated T_M ; (c) treated T_H 。



圖 12、茜素紅 S 染劑分析 hMSCs 於 O-PIII 處理前後純鈦金屬試 片表面培養 7 及 14 天後之初期分化情形: (a) untreated T_C ; (b) treated T_L ; (c) treated T_M ; (c) treated T_H 。